
	<h2 style="color: red;">FQD1N60CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD1N60CTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD1N60CTM.pdf 2.FQD1N60CTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51994 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	51994 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD1N60CTM-ND

FQD1N60CTM ist neu im Original. Suche FQD1N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>
 <p>FQD1N60C FAIRCHILD FQD1N60C FAIRCHILD</p>	 <p>FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17N08LTM	↔ FQD17N10	⇒ FQD17P06	D FQD17P06TF	↔ FQD17P06TF
⊣ FQD17P06TM	⊗ FQD17P06TM	D FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM	↔ FQD18N20V2TM
⊗ FQD19N10	⊣ FQD19N10L	⊗ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10TF
D FQD19N10TF	⊗ FQD19N10TM	⊣ FQD19N10TM	⊗ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF
⇒ FQD1N50TF	↔ FQD1N60C	⊗ FQD1N60CTF	⊣ FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTM
↔ FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TF	D FQD1N60TM	⊗ FQD1N60TM	⊣ FQD1N80TM
⊗ FQD1N80TM	D FQD1P50TM	⇒ FQD1P50TM	↔ FQD20N06	↔ FQD20N06-NL
⊣ FQD20N06L	⊗ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LTF
⊗ FQD20N06LTF	⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	D FQD20N06LTU	↔ FQD20N06TF
↔ FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	↔ FQD24N08TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

